

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 6 部門第 2 区分
 【発行日】平成 17 年 10 月 27 日 (2005.10.27)

【公開番号】特開 2000-56479 (P2000-56479A)

【公開日】平成 12 年 2 月 25 日 (2000.2.25)

【出願番号】特願 平 10-224113

【国際特許分類第 7 版】

G 0 3 F 7/42
 C 0 9 K 13/04
 C 1 1 D 7/00
 G 0 3 F 1/08
 G 0 3 F 7/36
 H 0 1 L 21/3065
 H 0 1 L 21/306
 H 0 1 L 21/3213

【F I】

G 0 3 F 7/42
 C 0 9 K 13/04
 C 1 1 D 7/00
 G 0 3 F 1/08
 G 0 3 F 7/36
 H 0 1 L 21/302 N
 H 0 1 L 21/306 S
 H 0 1 L 21/88 C

【手続補正書】

【提出日】平成 17 年 7 月 22 日 (2005.7.22)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

半導体製造工程でのドライエッチングの際に発生するサイドウォールを半導体基板から除去する方法において、前記半導体基板を硝酸水溶液に浸漬、水洗処理した後にサイドウォール除去液でサイドウォールを除去することを特徴とするサイドウォールの除去方法。

【請求項 2】

前記硝酸水溶液の濃度が 0 . 1 ~ 8 0 重量 %であることを特徴とする請求項 1 記載のサイドウォールの除去方法。

【請求項 3】

前記硝酸水溶液への浸漬時間が 1 秒 ~ 1 時間であることを特徴とする請求項 1 あるいは請求項 2 記載のサイドウォールの除去方法。

【請求項 4】

請求項 1 から請求項 3 のいずれか 1 項に記載の除去方法により、サイドウォールが除去された半導体デバイス。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 2

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 0 1 2 】

本発明の請求項 3 の発明は、請求項 1 あるいは請求項 2 記載のサイドウォールの除去方法において、前記硝酸水溶液への浸漬時間が 1 秒 ~ 1 時間であることを特徴とする。

本発明の請求項 4 の発明は、請求項 1 から請求項 3 のいずれか 1 項に記載の除去方法により、サイドウォールが除去された半導体デバイスである。